

بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های مختلف تحت تابش چشم‌گاما به منظور کاربرد در دزیمترا

عفت عصار نوقابی^{*}، حسن الهداغی، بهنام آزادگان، علی‌اصغر مولوی و جواد باعدی

دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی، ایران.

*خراسان رضوی، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم پایه، کدپستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷

پست‌الکترونیکی: e.assar88@gmail.com

چکیده

در این پژوهش برای اولین بار خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های مختلف تحت تابش پرتوهای گاما کیالت-۶۰ مورد بررسی قرار گرفت. نقاط کوانتومی CdS به رویی سریع، ساده و محلول در آب با استفاده از تابش ریزموچ خانگی سنتز شدند. نقاط کوانتومی با سه غلظت مختلف mg/cc ۰/۰، ۰/۲ و ۰/۲۰ در بازه دز Gy ۰-۲۰ در معرض چشم‌گاما قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت نقاط کوانتومی CdS، حساسیت ماده نسبت به تابش کم و آسیب نوری نقاط کوانتومی کاهش می‌یابد. به طوری که برای کمترین مقدار غلظت در دز Gy ۰/۰ ماده کاملاً نورتابی خود را از دست داد و شدت فوتولومینسانس صفر گردید، در حالی که برای بیشترین غلظت در دز Gy ۰/۲ ماده نورتابی قابل توجهی داشت. شدت فوتولومینسانس نقاط کوانتومی برای غلظت‌های mg/cc ۰/۰ و ۰/۲ با افزایش دز تا Gy ۰/۱، افزایش یافت. با تحلیل طیف‌های نوری مشخص شد که تابش گاما فقط باعث رشد نقاط کوانتومی می‌شود. با توجه به سنجش دز مورد نظر می‌توان از غلظت مناسب برای این روش دزیمترا جدید استفاده کرد.

کلیدواژگان: نقاط کوانتومی، CdS، خواص نوری، تابش گاما، دزیمترا.

۱. مقدمه

شوند اثر محدودیت کوانتومی ظاهر می‌شود، که به این دلیل این نانوذرات نقاط کوانتومی نامیده می‌شوند [۳].

خواص نوری نقاط کوانتومی بر حسب میزان دز جذبی تابش‌های یونیزان در مطالعات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات شامل اثر تابش اشعه ایکس [۴]، پرتوهای گاما [۵، ۳]، ذرات آلفا [۶] و الکترون [۴، ۷] روی فلورسانس

نقاط کوانتومی نیمه‌رسانا و نانو سوسوزن‌ها اخیراً در حوزه زیست‌پزشکی مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند [۱-۲]، زیرا خواص نوری منحصر به فردی از قبیل طیف گسیلی قابل تنظیم، بهبود بازده کوانتومی فلورسانس و پایداری نوری نسبت به رنگدانه‌های آلی معمول دارند. هنگامی که اندازه نانوبولورها کمتر یا مساوی با اکسایتون‌های تولید شده در مواد حجمی‌شان

۲. مواد و روش‌ها

۱.۲. مواد شیمیایی

کادمیوم سولفات $3\text{CdSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ، سدیم تیوسولفات $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ، تیوگلیکولیک اسید^۱ (TGA)، اتانول ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)، استن (CH_3COCH_3) و آمونیاک (Na_4OH) از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.

۲.۲. روش سنتز نقاط کوانتمومی CdS

ابتدا محلول آبی از کادمیوم سولفات $3\text{CdSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ و سدیم تیوسولفات $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ به عنوان عامل پوششی با غلظت‌های 20 mM و 100 mM با حجم 60 cc تهیه گردید. سپس PH این محلول توسط NaOH روی عدد 9 تنظیم شد. در ادامه محلول آبی از سدیم تیوسولفات $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ با غلظت 260 mM و حجم 40 cc آماده گردید. به دلیل اینکه تمام ماده سدیم تیوسولفات در واکنش شرکت نمی‌کند غلظت این ماده بیشتر در نظر گرفته می‌شود. برای جلوگیری از رسوب محلول و واکنش‌های احتمالی بهتر است که محلول آبی $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ به صورت تازه آماده گردد.

محلول‌های تهیه شده به درون ظرف شیشه‌ای که دارای چندین سوراخ بر روی درپوش خود برای هم فشار بودن با محیط می‌باشد، منتقل گردید. سپس ظرف شیشه‌ای داخل اتاق ریزموج خانگی به مدت 5 دقیقه با توان تابشی 500 W قرار گرفت. پس از خارج نمودن محلول و سرد شدن در دمای اتاق به آن استن اضافه شد تا محلول به صورت شیری رنگ شود. در ادامه سانتریفیوژ با سرعت 3500 rpm به مدت 15 دقیقه انجام گردید و نقاط کوانتمومی CdS تهشیش شده دوباره در آب یون‌زدایی حل گردید. سه محلول با غلظت‌های 2 mg/cc ، 0.4 mg/cc و 0.2 mg/cc به داخل میکروتیوب منتقل شدند. از هر غلظت

مواد نانوکامپوزیت و نقاط کوانتمومی می‌باشد. این پژوهش‌ها خصوصاً گزارش [۳] امکان استفاده از نقاط کوانتمومی را به عنوان یک ذیمتر جدید تأیید می‌نماید.

در گزارش [۳] که در سال 2009 توسط استودیلکا و همکاران ارائه شده است، خواص نوری نقاط کوانتمومی CdSe/ZnS محلول در هگزان تحت تابش گاما کیالت-۶۰ در بازه $100-0\text{ Gy}$ بررسی گردید. ویترز و همکاران در سال 2008 آسیب نوری این نقاط کوانتمومی را تحت تابش گاما مورد ارزیابی قرار دادند. آن‌ها مشاهده نمودند که نقاط کوانتمومی CdSe/ZnS مقاومت تابشی ضعیفی دارد و پس از تابش 174 Gy به شدت آسیب دیدند [۸].

به هر حال جهت استفاده از نقاط کوانتمومی نورتاب به عنوان ذیمتر عوامل زیادی نقش دارد که مستلزم تحقیقات و فهم بیشتری می‌باشد. از مهمترین این عوامل می‌توان به اثر اندازه نقطه کوانتمومی، بهینه نمودن میزان غلظت نقاط کوانتمومی در محلول، دمای خود نقاط کوانتمومی و همچنین اثرات آهنگ‌ذره، نوع و انرژی تابش اشاره نمود [۹].

در این پژوهش برای اولین بار خواص نوری نقاط کوانتمومی CdS محلول در آب با غلظت‌های مختلف تحت تابش پرتوهای گاما مورد بررسی قرار گرفت. از چشممه گاما کیالت-۶۰ با دز تابشی در بازه $0-20\text{ kGy}$ استفاده گردید. نقاط کوانتمومی CdS به روشنی ساده و سریع تابش ریزموج سنتز گردیدند. این پژوهش نسبت به گزارشات ارائه شده [۳، ۵، ۸، ۹] چندین مزیت دارد. از جمله روش سریع و آسان سنتز نقاط کوانتمومی CdS ، فرار و غیر سمی بودن حلال آن و همچنین نقاط کوانتمومی CdS مقاومت تابشی بالایی تحت تابش گاما داشت که می‌تواند برای بازه بزرگتری از دز پرتوهای گاما به کار رود.

¹ Thioglycolic acid

افزایش دز پرتوی گاما تا 1 kGy می‌باید. در دز 20 kGy شدت فوتولومینسانس صفر شده است که بیانگر این است که نقاط کوانتومی به طور کامل نورتابی خود را از دست داده‌اند. اما باقیستی عوامل مختلف از قبیل غلظت و اندازه نقاط کوانتومی بهینه شود که یک رابطه مناسب بین شدت فوتولومینسانس و میزان دز تابشی برقرار باشد. در شکل ۱-ب طیف جذبی مربوط به قسمت الف بر حسب انرژی نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود برای نمونه مرجع (0 eV) نمودار در انرژی حدود $3/16 \text{ eV}$ به بعد تا انرژی $3/54 \text{ eV}$ دچار یک خیز شدید می‌شود. انرژی وسط این بازه $3/35 \text{ eV}$ حدوداً برابر گاف انرژی است. طول موج متناظر با انرژی $3/35 \text{ eV}$ از رابطه ($E = hc/\lambda$) برابر 375 nm می‌باشد. در حالی که در قسمت الف پیک شدت فوتولومینسانس در طول موج 475 nm اتفاق افتاده بود، بنابراین نورتابی نقاط کوانتومی مربوط به گاف انرژی نمی‌باشد بلکه بر اساس مقالات گزارش شده [۱۰-۱۱] نورتابی‌ها مربوط به نقص‌های سطحی می‌باشد. از مقایسه طیف‌های جذبی برای نمونه مرجع، دز 1 kGy و 20 kGy تابش گاما همانطور که مشاهده می‌گردد با افزایش دز، گاف انرژی کاهش یافته است. با کاهش انرژی گاف اندازه نقطه کوانتومی افزایش می‌باید [۱۰]. بنابراین با افزایش دز پرتوهای گاما اندازه نقاط کوانتومی افزایش یافته است. در نتیجه علت تغییرات شدت فوتولومینسانس به افزایش اندازه ذرات مربوط می‌شود. تابش گاما می‌تواند انرژی لازم برای رشد نانوذرات را فراهم کند. در مقالات اشاره می‌شود که تابش گاما در آب منجر به تولید عواملی همچون رادیکال آزاد، H^+ , e^+ , e^- ... می‌شود [۱۲]. رادیکال‌های آزاد باعث می‌شوند که مولکول‌های پوششی از سطح ذرات جدا شود و ذرات بهم چسبند و باعث رشد آن‌ها شود. در نهایت مولکول‌های پوششی اضافی درون محلول یا مولکول‌های جدا شده به سطح ذرات بزرگ چسبند طوری که محلول نهایی بعد از تابش، برای

یک نمونه به عنوان نمونه مرجع (دز 0 Gy) و دیگر نمونه‌ها برای دزهای مختلف تابش گاما در نظر گرفته شدند.

۳.۲. تابش‌دهی چشمی گاما

میکروتیوب‌های حاوی محلول نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های $0/4 \text{ mg/cc}$, $2/4 \text{ mg/cc}$ و 20 mg/cc چشمی گامای کبالت- 60 موجود در سازمان انرژی اتمی تحت تابش قرار گرفتند. آهنگ دز تابشی چشمی گاما ثابت و برابر با $1/52 \text{ Gy/S}$ و میزان دز تابشی در بازه $20-40 \text{ kGy}$ متغیر بود.

۴. مشخصه‌هایی

جهت سنتز نقاط کوانتومی از اتاق ریز موج خانگی GHz $2/45$ استفاده گردید. طیف فوتولومینسانس، طیف جذبی و طیف تبدیل فوریه مادون قرمز به ترتیب توسط دستگاه‌های Perkin-Elmer: UV-Vis Lambda 25 Avantes Shimadzu 8700s میکروسکوپ الکترونی عبوری^۱ (TEM) با استفاده از دستگاه JEOL-JEM 1400 با ولتاژ شتاب دهنده 120 kV به دست آمد.

۳. بحث و نتایج

۱.۳. اثر تابش گاما روی شدت فوتولومینسانس و طیف

CdS جذبی نقاط کوانتومی

شکل ۱-الف طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتومی CdS با غلظت نسبی $0/2 \text{ mg/cc}$, $0/4 \text{ mg/cc}$ را در ناحیه طول موج $400-650 \text{ nm}$ برای دزهای مختلف پرتوی گاما نشان می‌دهد. دزهای پرتوی گاما شامل $0, 10, 100, 1000, 20000 \text{ Gy}$ هستند. قله طیف در طول موج 475 nm مشاهده می‌شود. همانطور که مشاهده می‌گردد شدت فوتولومینسانس با

^۱ Transmissions Electron Microscope

شکل ۲، ۱ و ۳-الف نتیجه می‌شود که با افزایش غلظت نقاط کوانتمی میزان آسیب تابشی در 20 kGy کاهش یافته است، به طوری که در شکل ۳-الف که غلظت بیشترین مقدار را دارد (غلظت نسبی ۱) در 20 kGy شدت فوتولومینسانس میزان قابل توجهی (از 0 تا 1300) دارد و در شکل ۲-الف با غلظت نسبی $1/10$ شدت فوتولومینسانس بین 0 تا 200 تغییر کرده است.

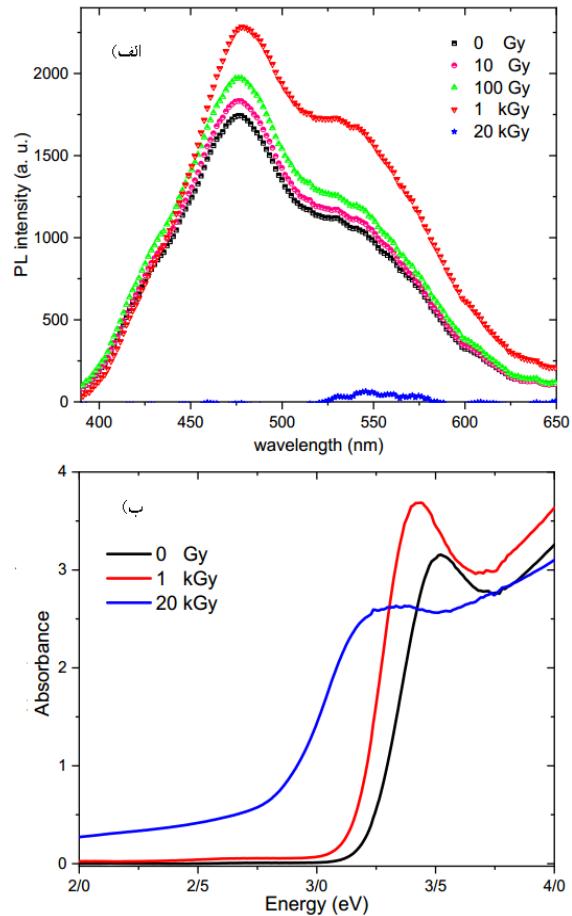
در حالی که در شکل ۱-الف که مربوط به نقاط کوانتمی با کمترین میزان غلظت (غلظت نسبی $1/100$) است، شدت فوتولومینسانس در 20 kGy تقریباً صفر شده است. بنابراین می‌توان استدلال نمود که با کاهش غلظت حساسیت ماده نورتاب نسبت به تابش افزایش می‌یابد. در نتیجه احتمال استفاده از نقاط کوانتمی با غلظت‌های بسیار پایین برای کاربرد در دزیمتری پرتوهای گاما در آینده وجود دارد.

شکل‌های ۲ و ۳-ب به ترتیب طیف جذبی قسمت الف شکل‌های ۲ و ۳ را نشان می‌دهند که تغییرات آن همانند شکل ۱-ب می‌باشد با این تفاوت که با افزایش غلظت، گاف انرژی در 20 kGy کاهش کمتری نسبت به گاف انرژی نمونه مرجع دارد. همانطور که ذکر شد با استفاده از نمودار طیف جذبی، می‌توان انرژی گاف را به دست آورد و با جایگذاری آن در رابطه تقریب جرم مؤثر [۱۰] اندازه نقاط کوانتمی CdS را می‌توان محاسبه نمود. رابطه تقریب جرم مؤثر که در زیر آمده است رابطه‌ای بین انرژی گاف نقاط کوانتمی و اندازه آنها می‌باشد.

$$E = E_{\infty} + \frac{h^2}{2d^2} \left(\frac{1}{\mu} \right) - \frac{3.572e^2}{3d} - \frac{0.779e^4}{h\varepsilon^2} \mu \quad (1)$$

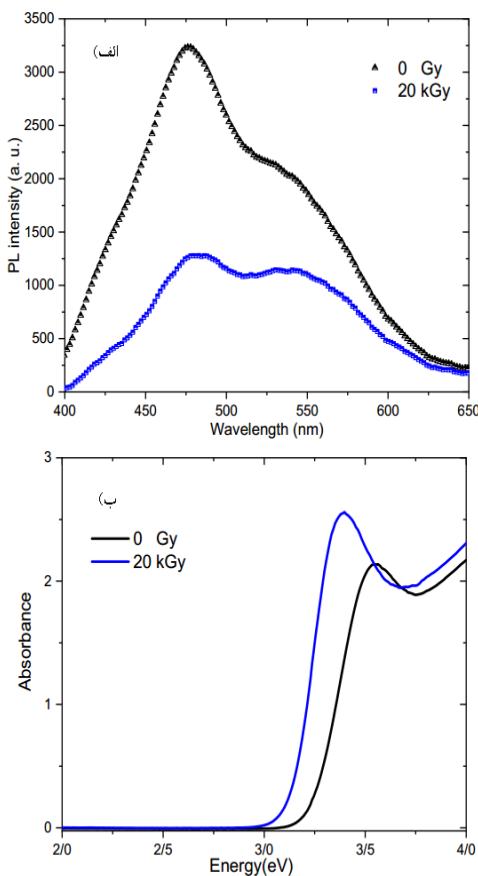
که E , E_{∞} , d , ε , μ , e , h و μ به ترتیب انرژی گاف نقطه کوانتمی، انرژی گاف ماده حجیم، قطر نقطه کوانتمی، جرم کاهش یافته الکترون و حفره، ضریب دی‌الکتریک، ثابت پلانک و بار الکترون می‌باشد.

ذراتی که زیاد رشد نیافته‌اند، از نظر شیمیابی پایدار است. در واقع می‌توان گفت که مکانیزم رشد استوالد رایپنینگ [۱۳] در اینجا صادق است. ذرات کوچکتر به نفع ذرات بزرگ کثیر رفته‌اند و اشعه گاما انرژی لازم برای این کار را فراهم می‌کند و سرعت رشد را تسريع می‌کند.

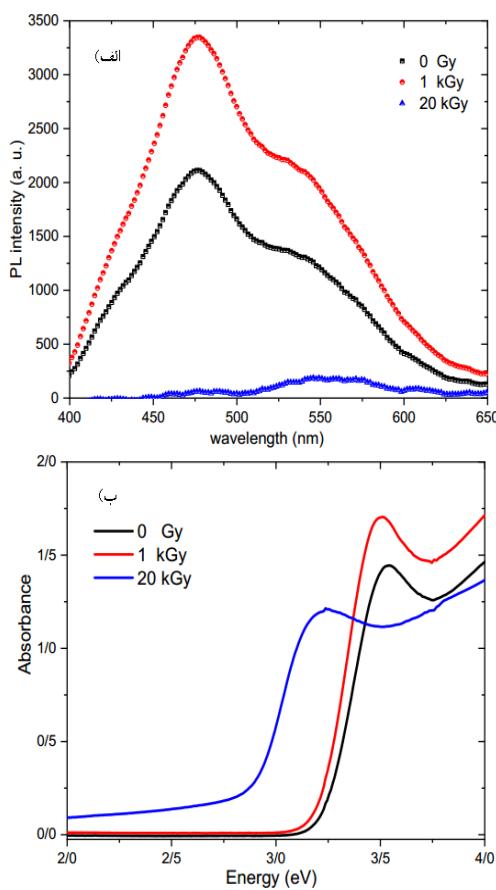


شکل (۱): (الف) طیف فوتولومینسانس و (ب) طیف جذبی نقاط کوانتمی CdS با غلظت نسبی $1/100$ برای دزهای مختلف پرتوی گاما.

شکل ۲-الف و ۳-الف طیف فوتولومینسانس نقاط کوانتمی CdS به ترتیب با غلظت‌های 2 mg/cc و 20 mg/cc در بازه طول موج $400-650 \text{ nm}$ را برای دزهای مختلف پرتوی گاما نشان می‌دهد. همانند شکل ۱-الف قله طیف در طول موج 475 nm اتفاق افتاده است. همچنین روند تغییر شدت فوتولومینسانس برای هر دو شکل با افزایش دز همانند شکل ۱-الف می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود از مقایسه سه



شکل (۳): (الف) طیف فوتولومینسانس و (ب) طیف جذبی نقاط کوانتمومی CdS با غلظت نسبی ۲۰ mg/cc (۰/۱) برای نمونه مرجع و دز ۲۰ kGy



شکل (۲): (الف) طیف فوتولومینسانس و (ب) طیف جذبی نقاط کوانتمومی CdS با غلظت نسبی ۰/۱ mg/cc (۰/۱) دزهای مختلف پرتوی گاما.

جدول (۱): اندازه و انرژی گاف نقاط کوانتمومی با غلظت‌های مختلف برای دزهای مختلف پرتوی گاما.

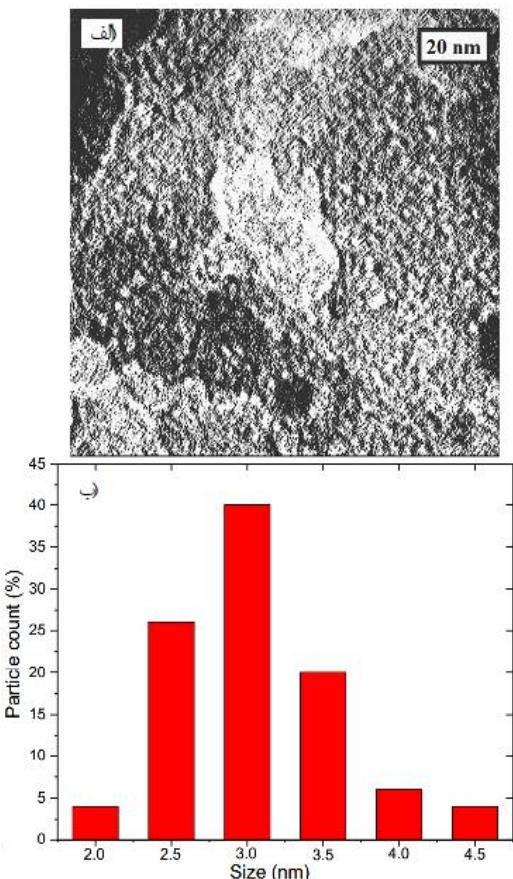
غلظت نسبی	اندازه نقطه کوانتمومی (nm)	انرژی گاف (eV)	دز گاما (kGy)
۰/۰۲	۳/۲۵	۳/۳۵	.
	۳/۴۷	۳/۲۳	۱
	۴/۲۲	۲/۹۵	۲۰
۰/۱	۳/۲۵	۳/۳۵	.
	۳/۳۰	۳/۳۲	۱
	۳/۹۷	۳/۰۳	۲۰
۱	۳/۲۵	۳/۳۵	.
	۳/۴۷	۳/۲۳	۲۰

در جدول ۱ اندازه و گاف انرژی نقاط کوانتمومی برای همه غلظت‌ها و دزهای مختلف پرتوی گاما بدست آمده است. داده‌های جدول نشان می‌دهد که برای همه غلظت‌های نقاط کوانتمومی با افزایش دز انرژی گاف کاهش و اندازه ذره افزایش یافته است. در نتیجه تابش پرتوهای گاما منجر به رشد ذرات شده است. همچنین مشاهده می‌شود در دز ۲۰ kGy با افزایش غلظت، اندازه نقطه کوانتمومی نسبت به نمونه مرجع (دز ۰ Gy) کمتر دچار تغییر شده است، به طوری که اندازه نقطه کوانتمومی مرجع ۳/۲۵ nm و در دز ۲۰ kGy برای غلظت‌های نسبی ۰/۰۲، ۰/۰۱ و ۱ به ترتیب برابر ۳/۹۷ nm، ۴/۲۲ nm و ۳/۴۷ nm می‌باشد. به عبارتی با افزایش غلظت، تأثیر تابش پرتوهای گاما روی رشد نانوذرات کاهش یافته است.

همانطور که مشاهده می‌شود قله مربوط به جذب کششی پیوند SH در طیف قسمت الف وجود ندارد، که بیانگر پیوند CdS با نقاط کوانتمی است.

۳.۳ اندازه نقاط کوانتمی

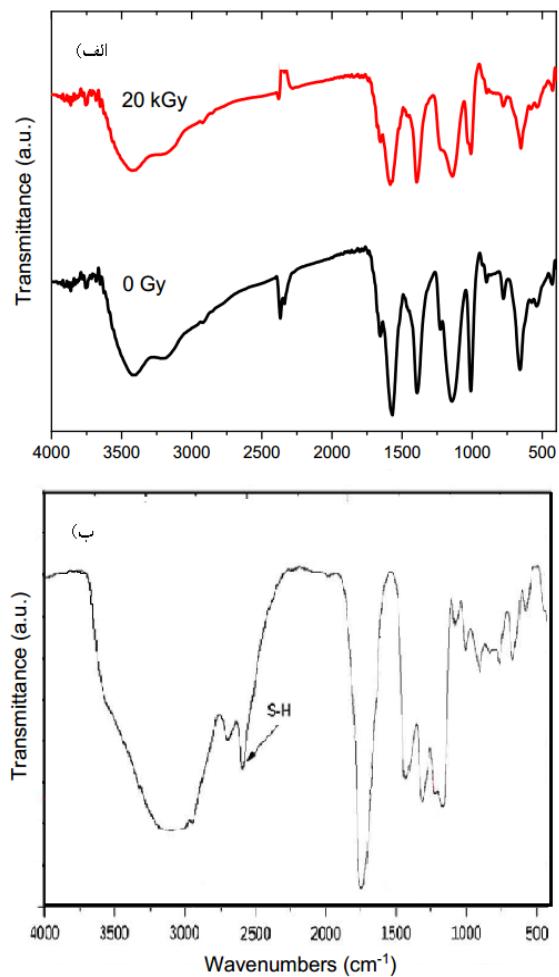
شکل ۵-الف تصویر میکروسکوب الکترونی عبوری نقاط کوانتمی نمونه مرجع را نشان می‌دهد. نقاط کوانتمی همان نقاط مشکی رنگ به صورت دایره‌ای مانند هستند. شکل ۵-ب هیستوگرام استخراج شده از تصویر قسمت الف می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌گردد اندازه اکثر نقاط کوانتمی برابر ۳ nm بود. اندازه نقاط کوانتمی مرجع که از رابطه تقریب جرم مؤثر $[10]$ محاسبه گردید برابر $3/25$ nm به دست آمد که تطابق خوبی با مقدار اندازه‌گیری شده دارد.



شکل (۵): الف) تصویر میکروسکوب الکترونی عبوری نقاط کوانتمی CdS مرجع و ب) هیستوگرام به دست آمده از قسمت الف.

۲.۳ اثر تابش گاما بر روی پیوندهای مولکولی

شکل ۴-الف طیف مادون قرمز نقاط کوانتمی با غلظت نسبی ۱ را برای نمونه مرجع و نمونه‌ای که تحت تابش 20 kGy قرار گرفته را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود تمام قله‌های جذب هر دو نمونه بر یکدیگر منطبق می‌باشد. بنابراین تابش گاما باعث شکست هیچ پیوند مولکولی نشده است. در نتیجه با توجه به طیف‌های نوری می‌توان گفت که مکانیزم اصلی تغییرات نورتابی تحت تأثیر تابش گاما رشد نقاط کوانتمی است. شکل ۴-ب طیف مادون قرمز مربوط به عامل پوششی تیوگلیکولیک اسید(TGA) می‌باشد [۱۱].



شکل (۴): طیف تبدیل فوریه مادون قرمز الف) نقاط کوانتمی با غلظت نسبی ۱ برای نمونه مرجع و نمونه‌ای تحت تابش 20 kGy و ب) عامل پوشش تیوگلیکولیک اسید (TGA) [۱۱].

۴. نتیجه‌گیری

کوانتوسومی افزایش می‌یابد. علاوه بر این طیف تبدیل فوریه مادون قرمز نشان داد که در اثر تابش گاما هیچ پیوند مولکولی دچار تغییر نشد، بنابراین تنها دلیل تغییرات مشخصات نوری تحت تأثیر تابش گاما، افزایش اندازه نقاط کوانتوسومی بود. در نهایت با توجه به روند افزایشی شدت فوتولومینسانس با افزایش دز چشممه گاما برای نقاط کوانتوسومی CdS با غلظت $4/0\text{ mg/cc}$ این نتیجه حاصل گردید که در غلظت‌های پایین، امکان استفاده از این ماده نورتاب در کاربردهای دزیمتری وجود دارد.

در این مقاله خواص نوری نقاط کوانتوسومی CdS تحت تابش پرتوهای گاما کیالت-۶۰-جهت کاربرد در دزیمتری مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های مختلف نقاط کوانتوسومی محلول در آب در بازه دز $20-0\text{ kGy}$ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با کاهش غلظت نقاط کوانتوسومی، حساسیت ماده نسبت به تابش گاما افزایش یافت بهطوری‌که در دز 20 kGy ماده کاملاً آسیب دید. برای نقاط کوانتوسومی با غلظت‌های $4/0\text{ و }2\text{ mg/cc}$ با افزایش دز تا 1 kGy شدت فوتولومینسانس افزایش یافت. با استفاده از طیف جذبی و رابطه تقریب جرم مؤثر مشاهده گردید که در اثر تابش پرتوهای گاما، اندازه نقاط

۵. مراجع

- [1] G. Gaur, D.S. Koktysh, D.M. Fleetwood, R.A. Weller, R.A. Reed, B.R. Rogers and S.M. Weiss. Influence of Ionizing Radiation and the Role of Thiol Ligands on the Reversible Photodarkening of Cdte/Cds Quantum Dots, *ACS Applied Materials & Interfaces*, 8 (2016) 7869–7876.
- [2] Y. Xing, Z. Xia and J. Rao. Semiconductor Quantum Dots for Biosensing and in Vivo Imaging, *IEEE transactions on nanobioscience*, 8 (2009) 4–12.
- [3] R.Z. Stodilka, J.J. Carson, K. Yu, M.B. Zaman, C. Li and D. Wilkinson. Optical Degradation of Cdse/Zns Quantum Dots Upon Gamma-Ray Irradiation, *The Journal of Physical Chemistry C*, 113 (2009) 2580–2585.
- [4] Y.M. Azhniuk, A. Gomonnai, M. Kranjčec, V. Lopushansky, I. Megela and D. Goyer. Irradiation-Induced Ionization of Glass-Embedded Cds_{1-X}Se Nanocrystals, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures*, 17 (2003) 518–520.
- [5] Y. Li, X. Dong, J. Gao, D. Hei, X. Zhou and H. Zhang. A Highly Sensitive Γ -Radiation Dosimeter Based on the CeO₂ Nanowires, *Physica E: Low-dimensional systems and nanostructures*, 41 (2009) 1550–1553.
- [6] S. Letant and T.-F. Wang. Semiconductor Quantum Dot Scintillation Under Γ -Ray Irradiation, *Nano Letters*, 6 (2006) 2877–2880.
- [7] R. Leon, J. Nadeau, K. Evans, T. Paskova and B. Monemar. Electron Irradiation Effects on Nanocrystal Quantum Dots Used in Bio-Sensing Applications, *IEEE transactions on nuclear science*, 51 (2004) 3186–3192.
- [8] N.J. Withers, K. Sankar, B.A. Akins, T.A. Memon, T. Gu, J. Gu, G.A. Smolyakov, M.R. Greenberg, T.J. Boyle and M. Osiński. Rapid Degradation Of CdSe/ZnS Colloidal Quantum Dots Exposed to Gamma Irradiation, *Applied Physics Letters*, 93 (2008) 173101.
- [9] P. Hobson, D. Leslie and D. Smith. Effect Of Gamma Radiation on Potential Ionising Radiation Detectors and Dosimeters Based on Quantum Dots, in: 2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, IEEE, 2011, pp. 3015–3017.
- [10] H. Alehdaghi, M. Marandi, M. Molaei, A. Irajizad and N. Taghavinia. Facile Synthesis Of Gradient Alloyed Zn_xCd_{1-x}S Nanocrystals Using a Microwave-Assisted Method, *Journal of alloys and compounds*, 586 (2014) 380–384.
- [11] M. Molaei, E.S. Iranizad, M. Marandi, N. Taghavinia and R. Amrollahi. Synthesis of Cds Nanocrystals By A Microwave Activated Method and Investigation of the Photoluminescence and Electroluminescence Properties, *Applied surface science*, 257 (2011) 9796–9801.
- [12] A.R. Ribeiro, O.C. Nunes, M.F. Pereira and A.M. Silva. An Overview On The Advanced Oxidation Processes Applied for the Treatment of Water Pollutants Defined in The Recently Launched Directive 2013/39/EU, *Environment international*, 75 (2015) 33–51.
- [13] L. Ratke and P.W. Voorhees, Growth And Coarsening: Ostwald Ripening in Material Processing, Springer Science & Business Media, (2013).